

2012 年度 応用物理学会シリサイド系半導体・夏の学校

プログラム(案)

7月28日(土)

12 : 00 受付開始, 事務連絡, 開催挨拶

13 : 00 招待講演1 圓谷志郎先生 (原子力機構)

「スピントロニクスのためのグラフェン/磁性金属界面の理解と制御」

14 : 00 講義1 今井庸二先生 (AIST)

「アルカリ土類金属シリサイドの不純物ドーピング」

15 : 00 休 憩

部屋割・鍵配布・チェックイン

16 : 00 講義2 前田佳均先生 (京都大学)

「 β -FeSi₂の発光と結晶純度, あたらしい発光増強について」

17 : 00 休 憩

入 浴 (大浴場 17 : 00~22 : 00)

18 : 30 夕 食

20 : 30 休 憩

20 : 45 特別記念講演 植草新一郎先生 (明治大学名誉教授)

「私の歩んだ道」

22 : 00 APAC-SILICIDE 2012 組織委員会 (立岡委員長)

24 : 00 終了

7月29日(日)

7：30～8：30 朝食

8：30 チェックアウト

9：00 招待講演2 都甲薫先生（筑波大学）

「Al 誘起成長法を用いた Si 薄膜/ガラスの結晶方位制御」

10：00 講義3 中村芳明先生（大阪大学）

「Si基板上へのナノ構造エピタキシャル成長技術とその応用」

11:00-12:30 ポスターセッション

12：30 おわりの挨拶，事務連絡